

独立行政法人 日本学術振興会
結晶加工と評価技術 第145委員会
第147回研究会資料

テーマ：「パワーデバイス用エピタキシャル成長装置の現状」ーエピウエハ量産化の課題ー

日 時：2015年12月25日（金）13：00～17：00

場 所：明治大学 駿河台キャンパス グローバルフロント 1階 多目的室

世話人：大谷 昇（関西学院大学）、土田 秀一（電力中央研究所）、
山本 秀和（千葉工業大学）、西澤 伸一（産業技術総合研究所）

プログラム：

13：00～13：05

開会の挨拶 田 島 道 夫

13：05～13：10

はじめに 大 谷 昇

13：10～13：45

(1) 「SiC エピ／ウエハ統合評価プラットフォーム」1
技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構 北 島 真
(現所属：東洋炭素株式会社)

13：45～14：20

(2) 「パワーデバイス用 Si エピウエハ中の結晶欠陥評価」7
日鉄住金テクノロジー株式会社 中 居 克 彦
" 二 木 登史郎
" 永 井 哲 也
" 野 網 健 悟
千葉工業大学 山 本 秀 和

14：20～14：55

(3) 「パワーデバイス用 Si 及び SiC 高速エピタキシャル成長装置の開発」11
株式会社ニューフレアテクノロジー（NFT） 三 谷 慎 一
TFW 装置技術部

14 : 55 ~ 15 : 10

休 憩

15 : 10 ~ 15 : 45

- (4) 「GaN 系エピタキシャル結晶成長の現状と今後の展望」15
大陽日酸(株) GI 本部化合物事業部 松 本 功

15 : 45 ~ 16 : 20

- (5) 「Planetary Reactor® for SiC and GaN: Advances in wide band-gap semiconductor manufacturing for efficient power devices」20
AIXTRON K.K. ○ Kentaro Harada
AIXTRON SE Frank Wischmeyer

16 : 20 ~ 16 : 55

- (6) 「量産型 SiC エピタキシャル成長装置の開発」21
東京エレクトロン山梨(株) 山梨技術開発センター ○ 原 島 正 幸
" 佐 野 志 生
" 小 林 洋 克
" 森 崎 英 介

16 : 55 ~ 17 : 00

おわりに 土 田 秀 一

17 : 00 ~ 17 : 20

委員総会

17 : 40 ~ 19 : 40

意見交換会 (会場 : 明治大学駿河台キャンパス グローバルフロント 17 階
グローバルラウンジ)